

фазе) Б. является медленно меняющимся рентг. источниками с  $L_X \approx 10^{36} - 10^{37}$  эрг/с и энергией фотонов  $\epsilon < 15$  кэВ. Если для описания спектра рентг. вспышки принять *Иланка закон излучения*, то радиус излучающей области составляет  $\sim 10$  км.

Интервал между вспышками  $t_r$  не остаётся постоянным, он меняется в пределах 3—50%. У одного из Б. (MXB 1730—335) обнаружены два типа вспышек (рис. 2): вспышки с интервалами  $\sim 100$  с (вспышки 2-го типа) прерываются раз в 3—4 ч обычной вспышкой (1-го типа). У вспышек 2-го типа  $t_R$  составляет неск. секунд,  $t_D$  — от неск. секунд до минут. Для трёх Б. (MXB

**БАРЬЕРНАЯ ЁМКОСТЬ** — электрич. ёмкость двойного слоя объёмного заряда в  $p-n$ -переходах и переходах металла—полупроводник (см. *Шоттки барьера*). В  $p-n$ -переходах приграничные слои полупроводников обеднены сен. носителями и, следовательно, заряжены: объёмная плотность заряда в каждом слое равна концентрации  $N$  легирующей примеси. Электрич. после объёмного заряда формирует энергетич. барьер  $U$ . Внешн. напряжение  $V$ , приложенное к переходу, изменяет высоту барьера. При этом изменяется ширина заряж. слоёв  $W(V)$  и их заряд  $Q = e \int_0^W N(x) dx [e]$ .

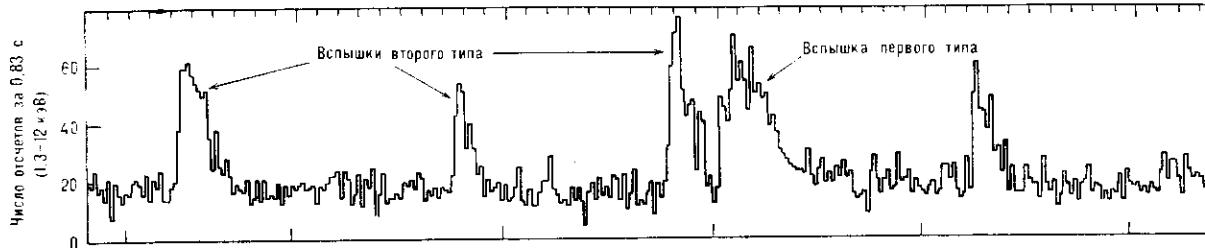


Рис. 2. Серия вспышек «быстрого» барстера MXB 1730—335 (среди частых вспышек видна одна обычная вспышка — 1-го типа).

1735—44, MXB 1837+0,5, MXB 1636—53) наблюдались как рентг., так и оптич. всплески излучения, близкие по продолжительности, но с запаздыванием  $\tau \approx 3\sigma$  оптич. всплеска относительно рентгеновского. Наличие оптич. «ха» позволяет предположить, что Б. — тесная двойная звёздная система, в к-рой рентг. излучение одного компонента поглощается и перезадаётся в оптич. диапазоне др. компонентом, находящимся на расстоянии  $\Delta r \sim c\tau \approx 10^{11}$  см.

Анализ данных наблюдений позволил определить орбитальные периоды, к-рые у семи источников оказались меньше 10 ч. Принято, что Б. представляют собой тесную двойную систему из красного карлика (с массой  $M < 1 M_\odot$ ) и нейтронной звезды. В такой системе красный карлик, заполнив в процессе эволюции *половину Роза*, начинает терять вещество, которое перетекает на нейтронную звезду (см. *Эволюция звёзд, Аккремация*).

В рамках данной модели рентг. излучение Б. в спокойной фазе обусловлено выделением гравитаций. энергии вещества, аккрецируемого нейтронной звездой. Термовая эволюция аккрецируемого слоя (до горения термоядерного топлива) определяется двумя процессами — адабатич. сжатием вещества и его охлаждением за счёт лучистой или электронной теплонпроводности. Если в момент загорания водорода или гелия вещество вырождено, то развивается тепловая вспышка (см. *Гелиевая вспышка*), приводящая к быстрому увеличению темп-ры, что в свою очередь ускоряет процесс энерговыделения и способствует выделению за короткое время большого кол-ва энергии, гл. обр. в виде рентг. излучения.

Существ. доводом в пользу термоядерной модели Б. является наблюдат. факт, что у Б. отношение  $\alpha$  энерговыделения в период между вспышками (связанного с аккрецией) к энерговыделению во время всплеска рентг. излучения (термоядерный взрыв той же массы вещества) близко к 100. Такое же значение  $\alpha$  следует из теории.

Паряду с рентг. Б. обнаружены два гамма-Б. (т. е. источники повторяющихся гаммовых излучений): 1) гамма-Б., открытый 5 марта 1979 (обнаружено более 10 гаммовских); 2) источник в созвездии Ориона (обнаружены 3 гаммовских). Теоретич. модель гамма-Б. не разработана.

*Лит.*: Эргма Э. В., Термоядерные вспышки в оболочках нейтронных звезд, в кн.: Итоги науки и техники, сер. Астрономия, т. 21, М., 1982; Lewis W. H. G., Joss P. C., X-ray bursters and the X-ray sources of the Galactic bulge, «Space Sci Revs», 1981, v. 28, p. 3.

элементарный заряд,  $N(x)$  — распределение примеси в слое]. Т. о., Б. ё. зависит от напряжения  $V$  и распределения примеси (на этом основаны ёмкостный метод определения распределения примеси в  $p-n$ -переходе и применение  $p-n$ -переходов в качестве управляемых ёмкостей — вариакторов). В случае симметричного  $p-n$ -перехода с  $N = \text{const}$  Б. ё. определяется ф-лой

$$C_0 = \left[ \frac{\epsilon e S N}{2(U \pm V)} \right]^{1/2}, \quad (1)$$

где  $S$  — площадь перехода,  $\epsilon$  — диэлектрич. проницаемость полупроводника. Для  $N = N_0 - ax$ :

$$C_b = \left[ \frac{\epsilon e^2 S a}{12(U \pm V)} \right]^{1/2}.$$

*Лит.* см. при ст. *Полупроводники*.

В. А. Герель.

**БАУШИНГЕРА ЭФФЕКТ** — снижение пределов пропорциональности, упругости и текучести материалов в результате изменения знака нагрузки, если первонач. нагрузка вызвала наличие пластич. деформаций. Металлы, подвергнутые слабой пластич. деформации нагрузкой одного знака, обнаруживают при перемене знака нагрузки понижение сопротивление нач. пластич. деформациям. Б. э. связывают с наличием остаточных напряжений в рабочих деформир. зёдрах металла, к-рые, складываясь с рабочими напряжениями при изменении знака нагрузки, вызывают понижение указанных выше характеристик образца.

Б. э. назв. по имени И. Баушингера (J. Bauschinger). **БЕГУЩАЯ ВОЛНА** — волновое движение, при к-ром поверхность равных фаз (фазовые волновые фронты) перемещается с конечной скоростью, постоянной в случае однородных сред (см. также *Волны*). С Б. в., *групповая скорость* к-рой отлична от нуля, связан перенос энергии, импульса или др. характеристик, показательных для данного процесса.

В рамках справедливости *суперпозиции принципа* (линейные системы) две одинаковые периодич. Б. в., распространяющиеся в противоположных направлениях, образуют стоячую волну. При разных амплитудах возникает частично Б. в., к-рая характеризуется или коэф. бегущести волны (КБВ), или коэф. стоячести волны (КСВ), или коэф. отражения Г, равным отношению амплитуд встречных волн, причём

$$KCB = \frac{1}{KBB} = \frac{1 + |\Gamma|^2}{1 - |\Gamma|^2}.$$

Для оптим. передачи энергии по линиям передач необходимо их согласование, т. е. получение внутри ли-